



Транзистор 2Т819

ОКП 63 4114

ЭТИКЕТКА

ЮФЗ.365.086 ЭТ

Кремниевые эпитаксиальные меза-планарные п-р-п транзисторы 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В в металлокерамическом корпусе КТ-9 ГОСТ 18472-88, предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах аппаратуры специального назначения.

Схема расположения выводов**1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**1.1. Основные электрические параметры при $t_{окр} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение | Норма | |
|---|-----------------------|----------|----------|
| | | не менее | не более |
| Статический коэффициент передачи тока, ($U_{кб} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 5 \text{ А}$) | h_{213} | 20 | |
| Граничное напряжение, ($I_k = 100 \text{ мА}$, $t_w \leq 300 \text{ мкс}$, $Q \geq 100$), В | $U_{кэ0 гр}$ | 80 | |
| | | 60 | |
| | | 40 | |
| Пробивное напряжение коллектор-база, ($I_k = 1 \text{ мА}$), В | $U_{кб0 проб}$ | 100 | |
| | | 80 | |
| | | 60 | |
| | | 5 | |
| Пробивное напряжение эмиттер-база, ($I_3 = 5 \text{ мА}$), В | $U_{эб0 проб}$ | 5 | |
| | | | |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, ($I_k = 5 \text{ А}$, $I_3 = 0,5 \text{ А}$), В | $U_{кэ нас}$ | | 1 |
| Напряжение насыщения база-эмиттер, ($I_k = 5 \text{ А}$, $I_3 = 0,5 \text{ А}$), В | $U_{кэ нас}$ | | 1,5 |

1.2. Содержание драгоценных металлов в 1000 шт.

транзисторов:

золото 0,0247 гсеребро 23,0813 г1.3. Содержание цветных металлов:
медь 3,8 г в одном транзисторе.**2. НАДЕЖНОСТЬ**

2.1. Минимальная наработка транзисторов в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 25000 ч, а в облегченном режиме при мощности 0,5, токах и напряжениях не более 0,7 максимально допустимых значений, 40000 ч.

2.2. Гамма-процентный ресурс при $\gamma = 95\%$ в режимах и условиях, допускаемых ОТУ и ТУ, 50000 ч.

2.3. Минимальный срок сохраняемости транзисторов при хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с кондиционированием воздуха, а также транзисторов, смонтированных в защищенную аппаратуру, или в защищенном комплекте ЗИП, 25 лет.

При хранении транзисторов в упаковке предприятия-поставщика в неотопляемых хранилищах и под навесом, а также смонтированными в аппаратуру незащищенных объектов, сроки сохраняемости соответствуют ГОСТ В 22468-77.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данных транзисторов требованиям АА0.339.142 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в документе в технических условиях на транзисторы.

Гарантийный срок – 25 лет с даты изготовления.

Гарантийная наработка:

25000 ч – в режимах и условиях, допускаемых ТУ;

40000 ч – в облегченном режиме.

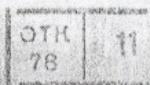
Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока.

4. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В соответствуют техническим условиям АА0.339.142 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № 2 от 9 02 04 дата

Место для штампа СКК



Место для штампа ПЗ

Место для штампа "Перепроверка произведена" дата

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Место для штампа СКК

Место для штампа ПЗ

Цена договорная